科目名		雷子		T学				Electronic devices and								
科目コード	電子機器工学 6215				表文表	记		equipments				平成26年3月14日				
教員名:比	名∶比嘉勝也													作成		
技術職員名:									<del></del>							
対象学科/専攻コース							年 必·選		履修	学修	単位	ī数	授業	形態	授業期間	
創造システム工学専攻・電子通信システム工学 コース							ì	巽	学	上修 2単位		位	講	義	後期	
科目目標	身の回りの様々な周辺機器(ディスプレイ・情報記憶装置・電力変換機器)について基本的動作原理を 理解し説明できることを目標とする。															
総合評価	総合評価 定期試験(中間・期末)の平均の80%+学習達成度チェックおよび宿題20% 評価は後期期中間までの評価と後期末までの評価の平均で行い、60%以上を合格とする.															
科目達成度目標(対応するJABEE教育目標) 達成度目標の評価方法										目標割合						
科目目標 達成度と													70%			
JABEE目 標との対	② 各機器の製造された技術的背景につい 理解する。(A-4)							⇒	正しく計算できるか定期試験および 講義での小テスト・宿題で評価する。					30%		
応								⇒								
	1	2	3	4	JABEE	JABEEプログラム4			: <b>3称                                    </b>					ム工学		
本科·専攻科 教育目標	0	<del>                                     </del>				BEEプログラム教育目							<b>√</b> −4			
					定期試験		スト	レポ	その他(演習課		習課題・	総合評価		セノ	セルフチェック	
評価	項目				80	10		10		0		100				
基礎的理解					40		5	5					0			
応用力(実践·専門·融合)					40		5		5			50				
社会性(プレゼン・コミュニケーション・PBL) 主体的・継続的学修意欲													) n			
授業概要、方針、	授業概 本講義では、前半にコンピュータ周辺機器であるディスプレイやハードディスなどの記憶装置などの弱電表、方針、機器について授業を行い、後半はパワーエレクトロニクスを中心にインバーター回路やパワーMOSなど <b>修上の</b> の半導体素子について授業を行う。										-Mosなど					
教科書• 教材	本部	専我 じ	<b>よ、</b> ⑦	<b>与凶</b> 書	を基に制作	・レバこノ	リント	を用い	<b>ි</b>							

授業計画										
週	授業項目	時間	授業内容	自学自習 (予習·復 習)内容	セルフ チェッ ク					
1										
2										
3										
- 4 5										
6										
7										
, 8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
期末		[2]	De Company							
16	ディスプレイ1	2	液晶ディスプレイの構造・原理について	小テスト・宿題						
17	ディスプレイ2	2	プラズマディスプレイの構造・原理について	小テスト・宿題						
18	電池	2	リチウム電池の構造・原理について	小テスト・宿題						
19	ストレーシュ	2	ハードディスクの構造について 半導体メモリについて	小テスト・宿題 小テスト・宿題						
20 21	ストレージ1 ストレージ2 A/D変換器	2	A/D変換器の構造について	小テスト・宿題						
22	D/A変換器	2 2	D/A変換器の構造について	小テスト・宿題						
23	中間試験	2	これまでの内容について試験を行う。	試験対策						
24	電力調整回路1	<u>-</u>	サイリスタの構造・原理について	小テスト・宿題						
25	電力調整回路2	2	直流チョッパ回路について	小テスト・宿題						
26	電力調整回路3	2	インバータ回路について	小テスト・宿題						
27	電力調整回路3 パワー半導体素子1	2	インバータ回路について パワーMOSの構造について	小テスト・宿題						
28	パワー半導体素子2	2	IGBTの構造について	小テスト・宿題						
29	インバータ回路の応用1	2	インバータ回路の応用について	小テスト・宿題						
30	インバータ回路の応用2	2	インバータ回路の応用について	試験対策						
期末	後期末試験 学習時間合計	[2] <b>30</b>	これまでの内容について試験を行う。 実時間							
	22.5									
			学修単位における自学自習時間の保証) 容について課題を課す。)(実施時間(目安)1~2時間)	標準的所用時間						
	各2時間×15回									
2	各2時間×15回									
	備考欄									

- ・ この科目はJABEE対応科目である。・ 関連科目:電子回路I・II(3年)、集積回路I(4年)、◎集積回路II(5年)、半導体物性工学(専攻科2年)

学習時間は、実時間ではなく単位時間で記入する。(45分=1、90分=2)

## 行動特性と評価方法 行動特性

11301011	行動特性	レベル5	レベル4	レベル3	レベル2	レベル1	評価方法
1	周辺機器やパワーエレクトロニクス	ディスプレイ、HDDなどコンピュータ周辺機器やパワーエレクトロニクスで使用される重要な回路やデバイスの動作原理を詳細を説明できる。	-	ディスプレイ、HDDなどコンピュータ周辺機器やパワーエレクトロニクスで使用される重要な回路やデバイスの動作原理の概略を説明できる。		ディスプレイ、HDDなどコンピュータ周辺機器やパワーエレクトロニクスで使用される重要な回路やデバイスの動作原理を参考文献を見ながら理解できる。	
2	各機器の製造された技術的背景に ついて理解する。	各機器の製造された技術的背景および社 会的要請およびその発展を説明できる。	:	各機器の製造された技術的背景 がどのように生まれたかについて その概略を説明できる。		各機器の製造された技術的背景があること を理解する。	